

大見研究室 和文 論文リスト

1990 年

- 183(M) 大見忠弘、「極限環境からの回答－超クリーン技術でLSI製造の低温化・完全制御を目指す」、日経マイクロデバイス 1990年 1月号、No.55、(日経BP社)、pp.108-114、1990年 1月。
- 184(P) 大見忠弘、新田雄久、「サブミクロンULSI製造プロセスにおけるAPIMS分析評価技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 2プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-4、1990年 1月。
- 185-1(P) 杉山和彦、中村雅一、大倉淳伸、水口泰光、大見忠弘、「APIMSの較正およびプロセス評価」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 2プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.29-40、1990年 1月。
- 186(P) 大見忠弘、新田雄久、「最先端技術分野における超精密洗浄技術の重要性」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 3プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-4、1990年 1月。
- 187-1(P) 河上道也、八木康之、佐藤賢一、大見忠弘、「高温・高圧超純水スプレー洗浄技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 3プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.5-22、1990年 1月。
- 185-2(M) 杉山和彦、中村雅一、大倉淳伸、水口泰光、大見忠弘、「APIMSの較正およびプロセス評価」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.2、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.21-30、1990年 1月。
- 188(M) 大見忠弘、川辺一郎、宮下雅之、三木正博、菊山裕久、坂喜代憲、高野順、「－極限環境からの回答－組成、反応生成物、析出、ぬれ性を制御してウェット工程を最適化」、日経マイクロデバイス 1990年 2月号、No.56、(日経BP社)、pp.124-129、1990年 2月。
- 157-2(M) 大見忠弘、竹浪敏人、稲葉仁、「トータルクリーンシステム－スーパークリーンルームの空調除塵システム－」、LSI製造におけるプロセス高性能化技術IV－クリーンルーム付帯設備の高度化－、(半導体基盤技術研究会)、pp.13-31、1990年 2月。
- 158-2(M) 竹浪敏人、稲葉仁、大見忠弘、「冷却水システム」、LSI製造におけるプロセス高性能化技術IV－クリーンルーム付帯設備の高度化－、(半導体基盤技術研究会)、pp.53-69、1990年 2月。
- 159-2(M) 稲葉仁、竹浪敏人、大見忠弘、「磁場対策」、LSI製造におけるプロセス高性能化技術IV－クリーンルーム付帯設備の高度化－、(半導体基盤技術研究会)、pp.143-151、1990年 2月。
- 160-2(M) 稲葉仁、大見忠弘、「静電気の影響」、LSI製造におけるプロセス高性能化技術IV－クリーンルーム付帯設備の高度化－、(半導体基盤技術研究会)、pp.197-217、1990年 2月。
- 161-2(M) 菊山裕久、坂喜代憲、高野順、三木正博、大見忠弘、「化学薬品用容器」、LSI製造におけるプロセス高性能化技術IV－クリーンルーム付帯設備の高度化－、(半導体基盤技術研究会)、pp.283-295、1990年 2月。
- 189(M) 大見忠弘、竹内南、「電力半導体デバイスの高性能化・インテリジェント化の動向」、電気学会雑誌平成2年2月号、Vol.110、No.2、((社)電気学会)、pp.81-82、1990年 2月。
- 190(M) 大見忠弘、宮脇守、「－極限環境からの回答－ 自然酸化膜成長を抑制、室温のコンタクト形成を実現」、日経マイクロデバイス 1990年 3月号、No.57、(日経BP社)、pp.112-117、1990年 3月。
- 191(M) 佐藤剛士、吉武春二、宮脇守、大見忠弘、「バイポーラデバイス高性能化のためのプロセス技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.89 No.472、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM89-188、pp.19-24、1990年 3月。

- 192(M) 室田淳一、御子柴宣夫、松浦孝、植竹宏明、大見忠弘、「一極限環境からの回答ー側壁の保護に吸着原子を使う異方性エッチング技術を開発」、日経マイクロデバイス 1990年4月号、No. 58、(日経BP社)、pp.88-94、1990年4月。
- 193(M) 宮脇守、吉武春二、佐藤剛士、大見忠弘、「自然酸化膜の成長抑制プロセスによるデバイス特性の高性能化」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90 No.15、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-3、pp.13-17、1990年4月。
- 194(M) 川辺一郎、宮下雅之、大見忠弘、高野順、坂喜代憲、菊山裕久、三木正博、「バッファードフッ酸によるSiO₂ウェットエッチングの最適化」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90 No.15、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-8、pp.41-46、1990年4月。
- 195(M) 坪内和夫、益一哉、御子柴宣夫、大見忠弘、丸井隆雄、梶川鉄夫、「多結晶薄膜の結晶粒一つ一つの結晶方位を手軽に判別」、日経マイクロデバイス 1990年5月号、No. 59、(日経BP社)、pp.106-111、1990年5月。
- 196-1(P) 大見忠弘、「超LSI製造におけるウルトラクリーン化技術と膜分離技術の役割」、第18回膜分離技術講演会、講演要旨集、(高分子膜分離技術振興協会)pp.16-23、1990年5月。
- 197(P) 大見忠弘、新田雄久、「新しいウェットプロセスを支える超純水技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 4、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-5、1990年5月。
- 198-1(P) 八木康之、河上道也、今岡孝之、大見忠弘、「最新の超純水製造システムー東北大学工学部ミニスーパークリーンルーム超純水装置の性能ー」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 4、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.19-43、1990年5月。
- 198-2(M) 八木康之、河上道也、今岡孝之、大見忠弘、「最新の超純水製造システムー東北大学工学部ミニスーパークリーンルーム超純水装置の性能ー」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.2、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.9-16、1990年4月。
- 187-2(M) 河上道也、八木康之、佐藤賢一、大見忠弘、「高温・高圧超純水スプレー洗浄技術」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.2、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.16-26、1990年4月。
- 199(M) 坪内和夫、益一哉、田中正則、樋浦洋平、大見忠弘、御子柴宣夫、丸井隆雄、林茂樹、寺本晃、梶川鉄夫、副島啓義、「走査形 μ m-RHEED顕微鏡の開発とVLSI用多結晶薄膜のグレイン評価への応用」、島津評論 Vol.47、No.1、pp.23-28、1990年5月。
- 200(C) 加藤義之、沖田彰、下西聡、柴田直、大見忠弘、新田雄久、「450°Cアニールによる浅いN⁺P接合形成とその電気的特性」、第13回イオン工学シンポジウム、イオン源とイオンを基礎とした応用技術：特別セミナー、(イオン工学会)、pp.171-174、1990年6月。
- 201(P) 大見忠弘、新田雄久、「ウルトラクリーンレジストワークショップ序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 5、プロシーディング、ウルトラクリーンレジストプロセッシング、(半導体基盤技術研究会)、1990年6月
- 202(P) 野仲徹、小野寺政信、堀越基伸、大見忠弘、「アウトガスフリーレジストプロセス」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 5、プロシーディング、ウルトラクリーンレジストプロセッシング、(半導体基盤技術研究会)、pp.59-92、1990年6月
- 203-1(P) 大見忠弘、新田雄久、「半導体プロセスを革新する新しいフッ素化学」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 11、半導体プロセスを革新する新しいフッ素化学、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-4、1990年7月。
- 204(P) 三木正博、植田守彦、米沢勲、大見忠弘、「フッ化水素酸の高純度化」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 11、半導体プロセスを革新する新しいフッ素化学、(半導体基盤技術研究会)、pp.27-77、1990年7月。
- 205-1(P) 菊山裕久、坂喜代憲、高野順、三木正博、川辺一郎、宮下雅之、大見忠弘、「バッファードフッ酸」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 11、半導体プロセスを革新する新しいフッ素化学、(半導体基盤技術研究会)、pp.79-107、1990年7月。

- 206-1(P) 川辺一郎、宮下雅之、大見忠弘、菊山裕久、三木正博、「HFガスをを用いた新しいプロセス」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 11、半導体プロセスを革新する新しいフッ素化学、(半導体基盤技術研究会)、pp.109-132、1990年7月。
- 207(P) 前野又五郎、丸橋一夫、中川佳紀、三木正博、大見忠弘、「F₂を用いた金属表面のフッ化処理ーステンレス鋼のフッ化処理ー」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 11、半導体プロセスを革新する新しいフッ素化学、(半導体基盤技術研究会)、pp.133-178、1990年7月。
- 208-1(P) 千葉和郎、三笠和、松下弘、前野又五郎、泉浩人、三木正博、大見忠弘、「F₂を用いた金属表面のフッ化処理ーアルミニウム合金のフッ化処理ー」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 11、半導体プロセスを革新する新しいフッ素化学、(半導体基盤技術研究会)、pp.179-204、1990年7月。
- 209(C) 柴田直、大見忠弘、「ウルトラクリーン化技術と薄膜形成(スパッタリング)ー低エネルギーイオン照射を用いた低温エピタキシャル成長技術ー」、第7回薄膜スクール資料、高度化する薄膜生成技術の基礎から最先端まで、(日本学術振興会 薄膜第131委員会)、pp.31-50、1990年7月。
- 210(C) 大見忠弘、柴田直、「プロセス環境と製造ライン」、サブハーフミクロンULSIテクノロジー講習会、((社)電子情報通信学会東京支部 シリコン材料・デバイス研究会集積回路研究専門委員会)、pp.38-45、1990年7月。
- 211(M) 大見忠弘、柴田直、桑原英司、「コンタクトのAlを平坦化マイグレーション寿命も1桁以上向上」、日経マイクロデバイス1990年7月号、No.61、(日経BP社)、pp.116-122、1990年7月。
- 212(C) 杉山和彦、水口泰光、大見忠弘、中村雅一、「熱酸化不動態処理を施したオールメタル製超高純度ガス供給系の施工と評価」、第8回大阪酸素ー半導体セミナー講演集、(大阪酸素工業㈱)、pp.5-25、1990年7月。
- 213(C) 大見忠弘、新田雄久「ー序文ー半導体グレードフッ素樹脂開発を志して」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 6、超高純度薬品デリバリーシステムとフッ素樹脂の高品質化、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-4、1990年7月。
- 214(C) 大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーによる極限微細化デバイスの研究開発」、UPU BOOK IN TER 研究論文集 '90、(㈱UPU)、pp.88、1990年7月。
- 215(M) 大見忠弘、柴田直、沖田彰、新田雄久、「450℃の低温アニールで逆方向のリーク電流を3桁低減」、日経マイクロデバイス1990年8月号、No.62、(日経BP社)、pp.92-96、1990年8月。
- 176-2(B) 小谷光司、大見忠弘、「RIE用ガス排気システム」大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅲ、(リアライズ社)、pp71-89、1990年、8月。
- 179-2(B) 杉山和彦、大見忠弘、水口泰光、中村雅一、「半導体工場用トータルガスシステムの設計概念」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅲ、(リアライズ社)、pp151-181、1990年、8月。
- 180-2(B) 加藤芳久、仲内宏、大見忠弘、「ウルトラクリーンボンベー設置、クリーニング、ガスの充填方法ー」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅲ、(リアライズ社)、pp183-196、1990年、8月。
- 181-2(B) 水口泰光、大見忠弘、杉山和彦、中村雅一、「酸化パッシベーションを施したプラスチック材料フリー、オールメタル製ガス供給システム」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅲ、(リアライズ社)、pp197-214、1990年、8月。
- 216(M) 森田瑞穂、寺本章伸、長谷川英司、河上道也、大見忠弘、「Si表面の自然酸化膜成長機構」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90、No.193、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-72、pp.21-26、1990年8月。
- 217(M) 笠間泰彦、八木康之、今岡孝之、大見忠弘、「高性能溶存酸素除去システムをそなえた超純水製造装置」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90、No.193、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-73、pp.27-31、1990年8月。

- 218(M) 都田昌之、宍戸昌広、早見由香、菅野洋一、大見忠弘、「縦型・横型拡散炉における流体の挙動」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90、No.193、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-75、pp.39-44、1990年 8月。
- 219(M) 松浦孝、植竹宏明、室田淳一、福田航一、大見忠弘、御子柴宣夫、小野昭一、「窒素添加塩素ECRプラズマによる n^+ ポリシリコンの高選択異方性エッチング」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90、No.194、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-83、pp.45-50、1990年 8月。
- 220(M) 後藤陽宏、佐々木真、ハンスダーク ルーヴェ、大見忠弘、柴田直、山上敦士、岡村信行、神谷攻、「次世代プラズマ装置におけるプラズマパラメータの精密制御」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90、No.194、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-85、pp.57-61、1990年 8月。
- 221(M) 小谷光司、柴田直、大見忠弘、「イオン照射プロセスによるMOSデバイスのホットエレクトロン耐性劣化の機構について」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90、No.194、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-86、pp.63-68、1990年 8月。
- 222-1(M) 大見忠弘、野仲徹、小野寺政信、堀越基伸、新田雄久、横田晃、「放出ガスを2桁減らすレジスト塗布・現象プロセスクリーンな N_2 雰囲気での高温ベーキング」、日経マイクロデバイス1990年 9月号、No.63、(日経BP社)、pp.86-92、1990年 9月。
- 222-2(P) 大見忠弘、「超高集積ULSIデバイスの問題点と将来」、日本機械学会第68期全国大会講演会講演論文集、Vol.A、((社)日本機械学会)、pp.562-564、1990年 9月。
- 223(B) 河上道也、大和田亮、八木康之、大見忠弘、「超純水評価技術(ウォーターマーク)」、Surface Science Technology 1、半導体基盤技術研究会編、超純水の科学、(リアライズ社)、pp.765-767、1990年 9月。
- 224(B) 河上道也、大見忠弘、「ウェットプロセスの概要」、Surface Science Technology 1、半導体基盤技術研究会編、超純水の科学、(リアライズ社)、pp.773-774、1990年 9月。
- 225(B) 河上道也、八木康之、大見忠弘、岡崎素弘、「ウォーターマークの生成条件」、Surface Science Technology 1、半導体基盤技術研究会編、超純水の科学、(リアライズ社)、pp.802-804、1990年 9月。
- 226(B) 河上道也、大和田亮、八木康之、大見忠弘、「自然酸化膜の低減」、Surface Science Technology 1、半導体基盤技術研究会編、超純水の科学、(リアライズ社)、pp.828-839、1990年 9月。
- 227(B) 八木康之、河上道也、佐藤賢一、大見忠弘、「高温高圧超純水スプレー洗浄技術」、Surface Science Technology 1、半導体基盤技術研究会編、超純水の科学、(リアライズ社)、pp.848-864、1990年 9月。
- 228(B) 大見忠弘、川辺一郎、宮下雅之、Fred Carn、「今後のウェットプロセス」、Surface Science Technology 1、半導体基盤技術研究会編、超純水の科学、(リアライズ社)、pp.865-876、1990年 9月。
- 229(M) 大見忠弘、「イオン密度とエネルギーを独立制御低損傷プラズマ平行平板型を開発—スパッタ、CV D、エッチングなど装置が兼用可能に—」、日経マイクロデバイス 1990年 10月号、No.64、(日経BP社)、pp.108-114、1990年 10月。
- 230(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.7 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 7、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-2、1990年 10月。
- 231-1(P) 中村雅一、大見忠弘、杉山和彦、水口泰光、川田幸司、大倉淳伸、「超高純度ガス供給系トータルシステム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 7、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-33、1990年 10月。
- 232-1(P) 川田幸司、中村雅一、杉山和彦、水口泰光、大倉淳伸、佐々木真、桑原英司、大見忠弘、「熱酸化不動態処理」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 7、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.37-57、1990年 10月。

- 233-1(P) 内沢修、菅野洋一、大川宏、朝倉利博、大見忠弘、「オールメタルバルブ」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 7、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.89-103、1990年10月。
- 234(M) 加藤義之、沖田彰、下西聡、柴田直、大見忠弘、新田雄久、「450°Cアニールによる浅いN⁺接合形成とその電気的特性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90、No.267、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-112、pp.15-19、1990年10月。
- 235(M) 大見忠弘、桑原英司、森田瑞穂、「界面を理論通りに制御できることを実証—クリーンなN₂中の洗浄や薄い酸化膜形成で前処理—」、日経マイクロデバイス 1990年11月号、No.65、(日経BP社)、pp.162-165、1990年11月。
- 236(M) 大見忠弘、森田瑞穂、「超LSI製造プロセスを革新するウルトラクリーンテクノロジー」、材料技術 1990年11月号、VOL.8、NO.9、(材料技術研究協会)、pp.3-7、1990年11月。
- 237(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.12 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1990年11月。
- 238-1(P) 大見忠弘、柴田直、「高性能半導体製造ライン」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-59、1990年11月。(英文)
- 239-1(P) 桑原英司、大見忠弘、宮脇守、「自然酸化膜フリープロセス」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.61-80、1990年11月。
- 240-1(P) 後藤陽宏、佐々木真、大見忠弘、「プラズマダメージ・チャンバー材料汚染をなくしたプラズマプロセス装置」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.81-111、1990年11月。
- 241-1(P) 浦野智秋、大見忠弘、柴田直、「半導体プロセス装置用排気システム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.113-128、1990年11月。
- 242-1(P) 小野寺政信、野仲徹、堀越基伸、大見忠弘、横田晃、新田雄久、「アウトガスフリーホトレジストプロセス」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.129-148、1990年11月。
- 243-1(P) 泊里治夫、浜田汎史、仲原善行、杉山和彦、大見忠弘、「半導体製造装置のための金属表面パッシベーション—酸化パッシベーション—」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.149-173、1990年11月。
- 244(P) 前野又五郎、中川佳紀、泉浩人、三木正博、千葉和郎、三笠和、松下弘、大見忠弘、「半導体製造装置のための金属表面パッシベーション—半導体製造装置のための金属表面フッ化処理—」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.175-208、1990年11月。
- 245-1(P) 中村雅一、大見忠弘、川田幸司、大木厚志、日置晃、「超高純度ガス供給用オールメタル酸化不動態配管技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.209-241、1990年11月。
- 246-1(P) 伊藤一男、大見忠弘、「半導体製造装置用ゲートバルブ—ウルトラクリーンテクノロジーを適用したオールメタルゲートバルブ—」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.243-259、1990年11月。
- 247-1(P) 林雄造、大見忠弘、「半導体製造装置用ゲートバルブ—無摺動ゲートバルブの開発—」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.261-283、1990年11月。
- 248(M) 寺本章伸、牧原康二、森田瑞穂、大見忠弘、「H₂O₂/Pt中前処理酸化を用いた熱酸化膜形成」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90、No.318、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-130、pp.75-79、1990年11月。

- 249(M) 森田瑞穂、寺本章伸、牧原康二、大見忠弘、中里泰章、内山敦夫、阿部孝夫、「極薄酸化膜を流れる電流のSi表面粗度依存性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90、No.318、シリコン材料デバイス、(社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM90-131、pp.81-85、1990年11月。
- 250(C) 稲葉仁、大見忠弘、「スーパークリーンルームテクノロジー」、高砂熱学工業総合研究所報 No.4 1990、(高砂熱学工業(株) 総合研究所)、pp.43-63、1990年11月。
- 251(M) 稲葉仁、大見忠弘、「スーパークリーンルーム技術 —静電気対策と空气中不純物—」、日経マイクロデバイス 1990年12月号、広告企画クリーン・ルーム特集、No.66、(日経BP社)、pp.141-158、1990年12月。
- 252(C) 石原良夫、大見忠弘、柴田直、「ウルトラクリーンイオン注入技術を用いて形成したpn接合の低温アニールにおける逆方向電流の低減」、日本酸素技No. 9-1990-、(日本酸素(株))、pp.50-60、1990年12月。
- 253(C) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.8 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 8、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-2、1990年12月。
- 254(C) 大見忠弘、「RCA洗浄の先見性と問題点」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 8、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.5-15、1990年12月。
- 255(C) 板野充司、川辺一郎、宮下雅之、大見忠弘、Reed W. ROSENBERG、「RCA洗浄工程における粒子の吸着脱離」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 8、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.35-55、1990年12月。
- 256(M) 杉山和彦、大見忠弘、中村雅一、水口泰光、鴨木三郎、溝上敏、「半導体製造用超高純度ガス供給技術」、材料技術 Vol.8、No.10、(材料技術研究協会)、pp.3(337)-7(341)、1990年12月。
- 257-1(M) 大見忠弘、「ウルトラクリーン技術」、日本機械学会誌、第94巻、第866号、(日本機械学会)、pp.70-74、1990年12月。
- 257-2(C) 島田久幸、広瀬浩一、野仲徹、小野寺政信、大見忠弘、「Photoresist Development by Surface Active Developer」、半導体・集積回路技術第39回シンポジウム講演論文集〔PROCEEDINGS OF THE 39TH SYMPOSIUM ON SEMICONDUCTORS AND INTEGRATED CIRCUITS TECHNOLOGY〕、(電気化学協会電子材料委員会)、pp.79-84、1990年12月。
- 257-3(C) 小野寺政信、野仲徹、堀越基伸、大見忠弘、新田雄久、横田晃、「Outgas Free Photoresist Processing」、半導体・集積回路技術第39回シンポジウム講演論文集〔PROCEEDINGS OF THE 39TH SYMPOSIUM ON SEMICONDUCTORS AND INTEGRATED CIRCUITS TECHNOLOGY〕、(電気化学協会電子材料委員会)、pp.85-90、1990年12月。
- 257-4(C) 桑原英司、大月正人、大見忠弘、「自然酸化膜フリープロセスによる理想的金属・半導体界面の形成 (Formation of Ideal Metal/Silicon Contacts by Native-Oxide-Free Processing)」、半導体・集積回路技術第39回シンポジウム講演論文集〔PROCEEDINGS OF THE 39TH SYMPOSIUM ON SEMICONDUCTORS AND INTEGRATED CIRCUITS TECHNOLOGY〕、(電気化学協会電子材料委員会)、pp.103-108、1990年12月。